

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年12 月24 日 (24.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/106730 A1

- (51) 国際特許分類: C23C 14/12, H05B 33/10, 33/14
(21) 国際出願番号: PCT/JP03/07669
(22) 国際出願日: 2003 年6 月17 日 (17.06.2003)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2002-175291 2002 年6 月17 日 (17.06.2002) JP
特願2002-293280 2002 年10 月7 日 (07.10.2002) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐々木 浩司

(SASAKI,Koji) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 成井 啓修 (NARUI,Hironobu) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 築嶋 克典 (YANASHIMA,Katsunori) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 目々澤 聡彦 (MEMEZAWA,Akihiko) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA,Tomoyuki); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).

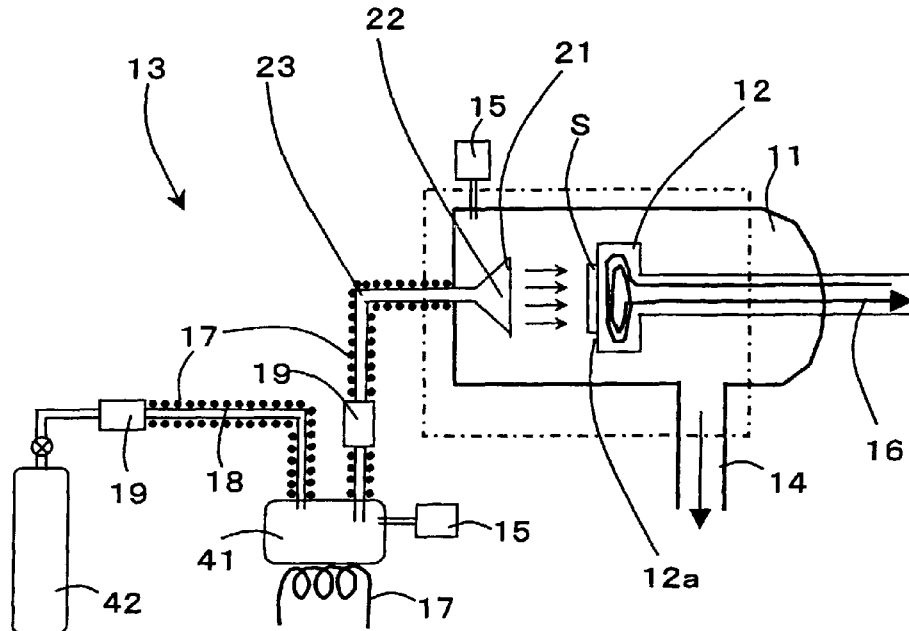
(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[続葉有]

(54) Title: THIN FILM-FORMING APPARATUS

(54) 発明の名称: 薄膜形成装置



(57) Abstract: A thin film-forming apparatus where raw material gas is uniformly supplied on a substrate surface and the thickness of an organic thin film can be uniformly formed on the substrate surface. The thin film-forming apparatus comprises a vacuum chamber (11), a substrate holder (12) provided in the vacuum chamber (11), and a gas supply end (22) for supplying gas to a substrate mounting face (12a) of the substrate holder (12). The apparatus is characterized in that the gas supply end (22) is formed such that the raw material gas is supplied to the substrate mounting face (12a) in an elongate shape.

[続葉有]



WO 03/106730 A1



添付公開書類：
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 基板表面に原料ガスが均一に供給され、基板表面に形成される有機薄膜の膜厚を均一にすることができ、薄膜形成装置である。真空チャンバ(11)と、真空チャンバ(11)内に設けられた基板ホルダー(12)と、基板ホルダー(12)の基板装着面(12a)に向けてガスを供給するガス供給端(22)とを備えた薄膜形成装置であって、ガス供給端(22)は基板装着面(12a)に原料ガスが長尺状に供給されるように形成されていることを特徴とする薄膜形成装置である。